

【1000 ~ 2000万円】SiC/IGBT Power Device Process Integration Expert

外資系デバイスメーカーでの募集です。 電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓...

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
外資系デバイスメーカー

Job ID
1586992

Industry
Communication

Company Type
International Company

Job Type
Permanent Full-time

Location
Osaka Prefecture

Salary
10 million yen ~ 20 million yen

Work Hours
09:00 ~ 18:00

Holidays
詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

Refreshed
November 14th, 2026 06:00

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2224782】
・SiC/IGBTパワー半導体プロセスインテグレーション構築を担当していただきます。
・部分工程であるプロセスモジュールインテグレーションの構築を進めていただきます。
・業界に先んじて最先端、高性能かつ高信頼な競争力の高いパワーデバイスの研究開発にプロセスインテグレーターとして貢献していただきます。
・最新のパワー半導体製造プロセスを調査・研究し、開発テーマを提案していただきます。
・プロセス設備導入に際して、設備選定等に助言をいただきます。

・革新的で競争力のあるプロセスプラットフォームを構築していただきます。

Required Skills

・おおよそ20年以上の半導体またはそのプロセス技術の研究・開発・製造における経験を持ち、SiC/IGBTプロセスインテグレーション開発業務に精通している。
・プロセスシミュレータに精通し、高性能SiC/IGBTパワー半導体プロセス開発を推進できる。
・半導体新工場の建設、設備選定、導入などのプロセスに精通している。
・半導体プロセス技術開発、プロセス設備開発、プロセス設備選定、開発ラインまたは生産ライン立ち上げ経験などの経験を持つ。
・生産現場における技術的ボトルネック改善や良品率向上などの課題解決の経験を持つ。
・最新のSiC/IGBTパワー半導体プロセス技術に詳しく、学会や業界に対し広い人脈を持つ。
・優れた学習能力、問題解決能力、コミュニケーション能力、職業倫理及びチームワーク精神を持っていること。
・海外出張に対応可能であること。基本的な英語のコミュニケーション能力とリーディング、ライティングスキルを有すること。

Company Description

ご紹介時にご案内いたします